



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

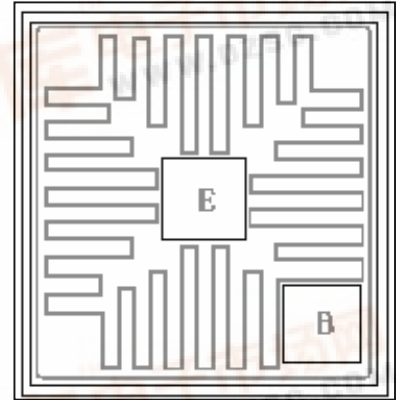
**HD965**

对应国外型号  
2SD965

### 芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)  
 芯片代码：C089AJ-00-XXX  
 芯片厚度：240 ± 20μm  
 管芯尺寸：890 × 890μm<sup>2</sup>  
 焊位尺寸：B 极 230×230μm；E 极 170×170μm  
 电极金属：铝  
 背面金属：金  
 封装形式：TO-92

### 芯片图



### 极限值 (T<sub>a</sub>=25 )

T<sub>stg</sub>——贮存温度..... -55~150  
 T<sub>j</sub>——结温..... 150  
 P<sub>C</sub>——集电极耗散功率..... 0.75W  
 V<sub>CBO</sub>——集电极—基极电压..... 40V  
 V<sub>CEO</sub>——集电极—发射极电压..... 20V  
 V<sub>EBO</sub>——发射极—基极电压..... 7V  
 I<sub>C</sub>——集电极电流..... 5A

### 电参数 (T<sub>a</sub>=25 )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I <sub>CBO</sub>	集电极—基极截止电流			100	nA	V <sub>CB</sub> =10V, I <sub>E</sub> =0
I <sub>EBO</sub>	发射极—基极截止电流			100	nA	V <sub>EB</sub> =7V, I <sub>C</sub> =0
V <sub>CEO</sub>	集电极-发射极电压	20			V	I <sub>C</sub> =1mA, I <sub>B</sub> =0
V <sub>EBO</sub>	发射极-基极电压	7			V	I <sub>E</sub> =10 μA, I <sub>C</sub> =0
h <sub>FE1</sub>	直流电流增益	180		800		V <sub>CE</sub> =2V, I <sub>C</sub> =0.5A
h <sub>FE2</sub>	直流电流增益	150				V <sub>CE</sub> =2V, I <sub>C</sub> =2A
V <sub>CE(sat)</sub>	集电极—发射极饱和电压			1	V	I <sub>C</sub> =3A, I <sub>B</sub> =0.1A
f <sub>T</sub>	特征频率	150			MHz	V <sub>CB</sub> =6V, I <sub>E</sub> =50mA
C <sub>ob</sub>	共基极输出电容			50	pF	V <sub>CB</sub> =20V, I <sub>E</sub> =0, f=1MHz